附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

| 序号 | 组别 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 主要起草单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一组 | 国标委发[2020]6号  20200801-T-469 | 硅单晶退火片 | 有研半导体材料有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]6号  20200800-T-469 | 硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法 | 乐山市产品质量监督检验所 | 预审 |
|  | 中色协科字[2020]8号  2020-023-T/CNIA | 多晶硅生产用氢气中金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2018]60号  20181808-T-469 | [半导体材料术语](http://zxd.sacinfo.org.cn:7001/default/com.sac.tpms.core.common.detailForQuery.projectDetailInfo.flow?projectID=113340&stage=plan) | 有研半导体材料有限公司 | 讨论 |
|  | 已公示，计划待下达 | 多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法 | 亚洲硅业（青海）股份有限公司 | 讨论 |
|  | 已公示，计划待下达 | [硅片流动图形缺陷的检测 腐蚀法](http://zxd.sacinfo.org.cn/default/com.sac.tpms.core.common.detail.projectDetailInfo.flow?projectID=129027&stage=plan) | 徐州鑫晶半导体科技有限公司 | 讨论 |
|  | 第二组 | 国标委发[2019]40号20194175-T-469 | 磷化镓单晶 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]6号20200798-T-469 | 磷化铟单晶 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]6号  20200799-T-469 | 碳化硅单晶抛光片 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]37号  20202826-T-469 | 碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]37号  20202830-T-469 | 碳化硅单晶位错密度的测试方法 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]53号20204893-T-469 | 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法 | 芜湖启迪半导体有限公司 | 讨论 |